

### 高温退火对物理提纯多晶硅位错密度及其电学性能的影响

徐华毕, 洪瑞江\*, 沈辉

中山大学太阳能系统研究所, 光电技术与材料国家重点实验室, 广州 510006

[摘要](#)[图/表](#)[参考文献\(0\)](#)[相关文章\(7\)](#)[点击分布统计](#)[下载分布统计](#)

版权所有 © 《中国科学》杂志社

地址: 北京市东黄城根北街16号, 《科学通报》编辑部, 100717

电话: 010-64036120 E-mail: csb@scichina.org

网络系统维护电话: 010-64034113 E-mail: sys@scichina.org